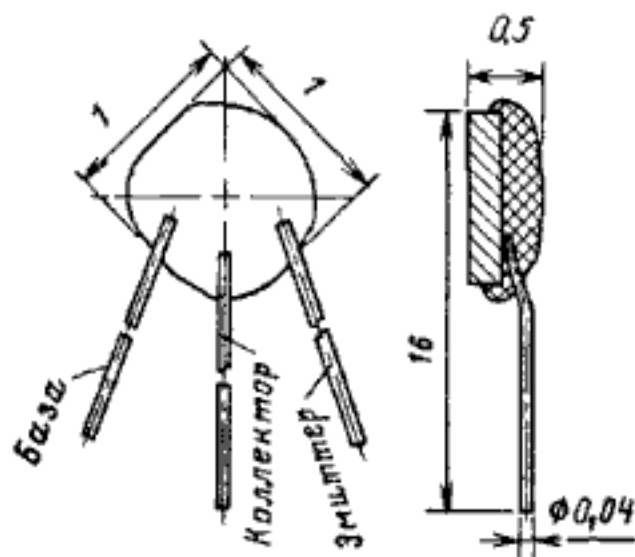


КТ211А-1, КТ211Б-1, КТ211В-1



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* с нормированным коэффициентом шума.

Предназначены для применения во входных каскадах, малошумящих усилителях, в герметизированной аппаратуре.

Бескорпусные, без кристаллодержателя, с защитным покрытием лаком, с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на возвратной таре.

Масса транзистора не более 0,01 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_K = 1$ мА не менее 10 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 1$ В, $I_Э = 40$ мА:
при $T = 298$ К:

КТ211А-1	40 – 120
КТ211Б-1	80 – 240
КТ211В-1	160 – 480

при $T = 398$ К:

КТ211А-1	40 – 200
КТ211Б-1	80 – 400
КТ211В-1	160 – 800

при $T = 213$ К:

КТ211А-1	20 – 120
--------------------	----------

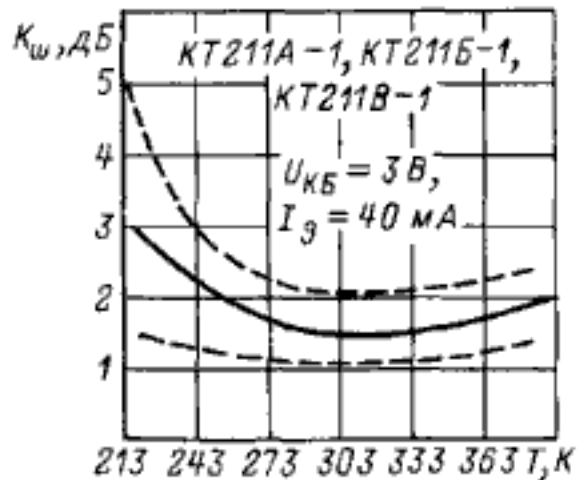
КТ211Б-1	40—240
КТ211В-1	80—480
Коэффициент шума при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 40$ мА, $f =$ $= 1$ кГц, $R_{Г} = 10$ кОм не более	3 дБ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 15$ В не более	10 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f =$ $= 10$ МГц не более	20 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f =$ $= 10$ МГц не более	15 пФ

Предельные эксплуатационные данные

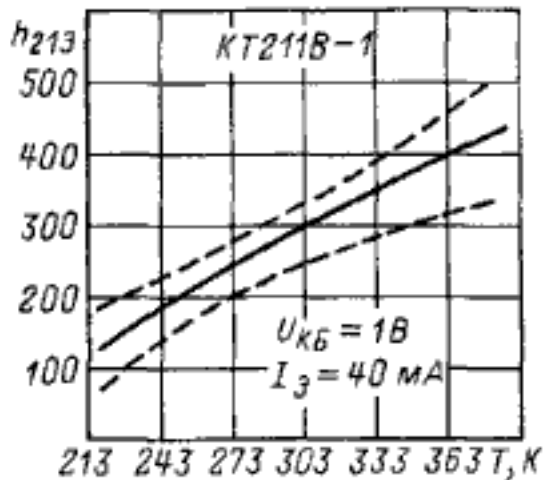
Постоянное напряжение коллектор-база	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	5 В
Постоянный ток коллектора	20 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_{и} \leq 10$ мкс, $Q \geq$ ≥ 10	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T = 213 \pm 308$ К	25 мВт
при $T = 398$ К	5 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $\tau_{и} \leq 10$ мкс, $Q \geq 10$	50 мВт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	От 213 до 398 К

Примечание При монтаже транзисторов в микросхему должны быть приняты меры, исключающие нагрев кристалла более 423 К. При монтаже транзисторов не допускается изгиб выводов на расстоянии менее 0,5 мм от места выхода из защитного покрытия

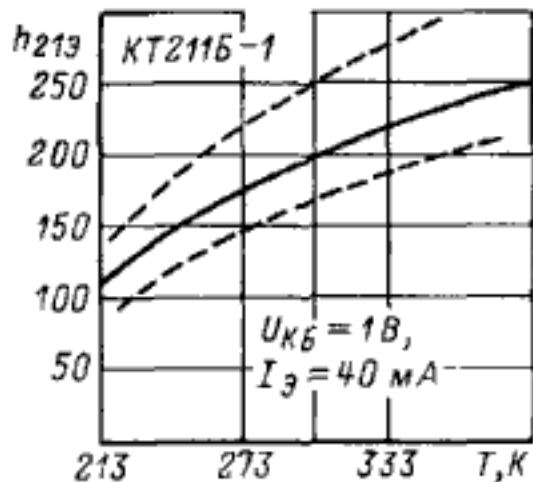
Пайка и сварка выводов допускается на расстоянии более 1 мм от места выхода вывода из защитного покрытия



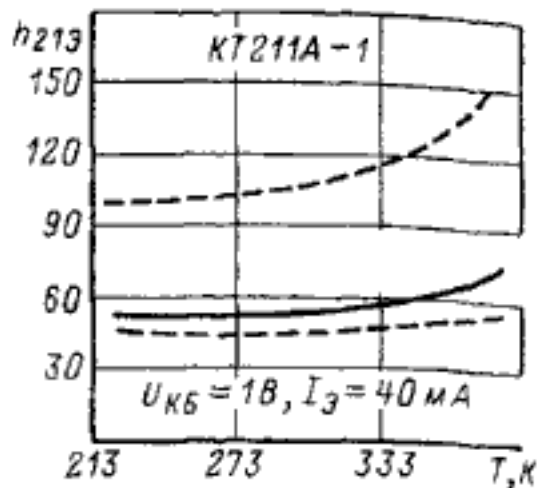
Зона возможных положений зависимости коэффициента шума от температуры.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры.